

公開シンポジウム

ポストスケーリング時代における 次世代革新的デバイスおよび材料の探索

JST戦略的創造事業さきがけ
革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス
2011年度成果報告会

第59回 応用物理学関係連合講演会

日時：2012年3月15日（木）9：00～17：45

会場：早稲田大学 早稲田キャンパス 15号館201（F6）

東京都新宿区西早稲田 1-6-1

半導体デバイスはスケーリング則に基づく微細化により高集積化が進んできましたが、その限界が見え始めてきました。ポストスケーリング時代を迎え、従来のCMOS技術を超える次世代革新的デバイスが待たれています。このシンポジウムでは、さきがけ研究で得られた成果を中心に、Geや化合物半導体などの高移動度材料、スピントロニクス材料、光配線技術、ワイドギャップ材料、超電導材料、サーモエレクトロニクス材料など次世代デバイスをめざす広範な材料について、その作製・評価やデバイス作製プロセスの開拓について議論を進めます。

なお、本シンポジウムは科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業さきがけ「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究領域（研究総括 佐藤勝昭）の第2期の研究成果の発信を兼ねて実施されるもので、JSTと応用物理学会の共同企画で行われます。



公益社団法人 応用物理学会

独立行政法人 科学技術振興機構